

M3F60**600V 3A****特長**

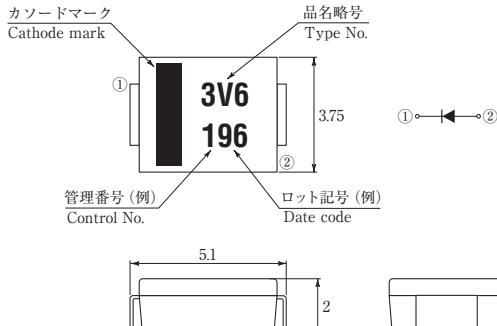
- ・小型 SMD
- ・耐湿性に優れ高信頼性

Feature

- Small SMD
- High-Reliability

■外観図 OUTLINE

Package : M2F

Unit : mm
Weight : 0.072g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

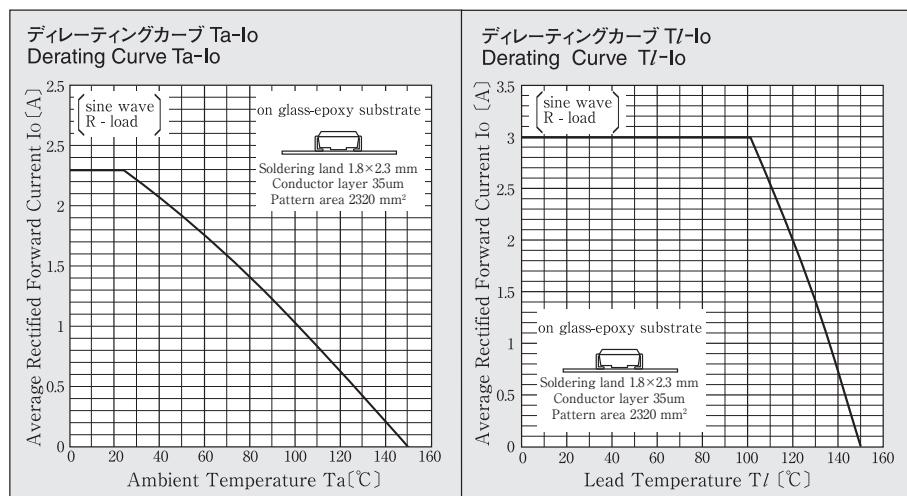
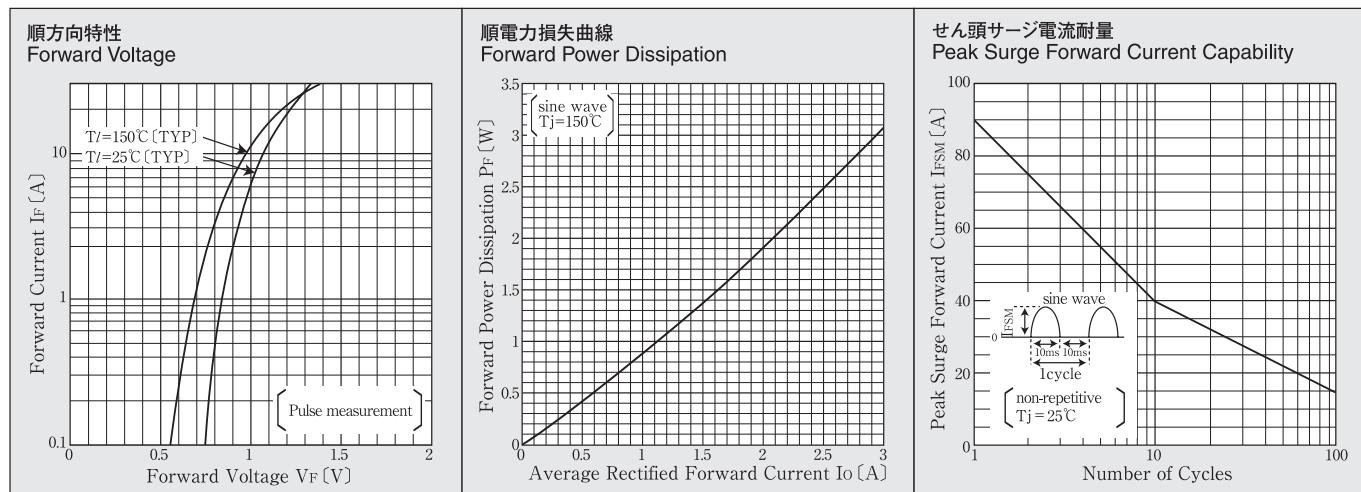
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_{l}=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	M3F60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, 50Hz sine wave, Resistance load	T _l =100°C Ta=25°C	3.0 2.3	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T _j =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j =25°C		90	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms≤t<10ms, T _j =25°C		40	A ² s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_{l}=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =3A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =600V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{JL}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 16	°C/W
	θ _{JA}	接合部・周囲間, プリント基板実装 Junction to Ambient, On glass-epoxy substrate	MAX 55	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.